

东西方面孔异族效应机理的电生理学证据

彭小虎, 罗跃嘉, 卫星, 王国锋, 魏景汉

中国科学院心理研究所, 北京 100101

收稿日期 2002-2-21 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 采取事件相关电位方法研究东西方面孔记忆编码的差异(DM效应), 从而阐明异族效应的神经机制。14名被试学习和再认东西方面孔照片的实验结果表明, 无论记住与否, 西方面孔产生的早期成分(潜伏期70~220ms)在头皮额部有一个比东方面孔更为正向的变化, 表明在此阶段更多的资源分配于异族面孔, 支持异族效应产生的特征选择假说。无论东方面孔还是西方面孔, 记住与未记住相比较, 则在额部和顶部产生潜伏期在晚期正成分(LPC)范围的正走向变化, 但西方面孔在240~320ms潜伏期范围内, DM效应较小。另外, 东方面孔在枕部诱发出一个明显的负波N260, 而西方面孔产生的N260很小甚至没有, 反映了大脑对不同种族面孔的编码机制有所不同, 因而可能被称为“种族特异波”

关键词 [事件相关电位](#) [异族效应](#) [DM效应](#) [记忆](#)

分类号 [842.2](#)

DOI:

对应的英文版文章: [030108](#)

通讯作者:

作者个人主页: 彭小虎; 罗跃嘉; 卫星; 王国锋; 魏景汉

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(OKB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“事件相关电位”的相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [彭小虎](#)
- [罗跃嘉](#)
- [卫星](#)
- [王国锋](#)
- [魏景汉](#)